

PUB-NO: DE019745966C1
**DOCUMENT-
IDENTIFIER:** DE 19745966 C1
TITLE: Low ohmic resistive layer of copper@-nickel@ alloy

PUBN-DATE: October 29, 1998

INVENTOR-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
BRUECKNER, WINFRIED DR	DE
REISS, GUENTER DR	DE
BAUNACK, STEFAN DR	DE
VOGEL, REGINA	DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
DRESDEN EV INST FESTKOERPER	DE

APPL-NO: DE19745966
APPL-DATE: October 17, 1997

PRIORITY-DATA: DE19745966A (October 17, 1997)

INT-CL (IPC): H01C007/06 , H01C017/08 , C23C014/14

EUR-CL **C23C014/14 , H01C007/06 , H01C017/08 ,**
(EPC): **H01C017/26**

ABSTRACT:

CHG DATE=19990905 STATUS=0>A low ohmic resistive layer, with adjustable low temperature coefficient of resistance (TCR), consists of a Cu-Ni based alloy applied without underlying and/or cover layers onto a substrate, the TCR being determined by the thickness of an oxide layer formed on the resistive layer. Preferably, the resistive layer comprises a sputter deposited alloy containing 30-60 wt.% Ni, 40-70 wt.% Cu and optionally up to 10 wt.% total of one or more transition metals and the oxide layer is formed to a thickness of 1-20% of the total layer thickness by heat treating at 300-500 deg C in an oxygen-containing atmosphere.



⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑯ Patentschrift
⑯ DE 197 45 966 C 1

⑯ Int. Cl. 6:
H 01 C 7/06
H 01 C 17/08
C 23 C 14/14

DE 197 45 966 C 1

- ⑯ Aktenzeichen: 197 45 966.8-34
⑯ Anmeldetag: 17. 10. 97
⑯ Offenlegungstag: -
⑯ Veröffentlichungstag der Patenterteilung: 29. 10. 98

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

⑯ Patentinhaber:

Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung
Dresden e.V., 01069 Dresden, DE

⑯ Erfinder:

Brückner, Winfried, Dr.habil., 01307 Dresden, DE;
Reiss, Günter, Dr.habil., 33602 Bielefeld, DE;
Baunack, Stefan, Dr., 01159 Dresden, DE; Vogel,
Regina, 01169 Dresden, DE

⑯ Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:

DD 2 92 340 A5

NISHINO, I. (u.a.): Evaluation of Cu-Ni Alloy as a Material of Thin Film Resistors. In: The International Journal for Hybrid Microelectronics, Vol. 8, Number 1, March 1985, S. 18-23;
BRÜCKNER, W. (u.a.): Adjustment of temperature coefficient of resistance in NiCr/CuNi(Mn)/NiCr films. In: J.Appl.Phys. 79 (11), 1 June 1996, S. 8516-8520;

⑯ Niederohmige Widerstandsschicht

⑯ Die Erfindung betrifft eine niederohmige Widerstandsschicht mit einstellbarem kleinen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands (TKR). Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine niederohmige Widerstandsschicht auf CuNi-Basis zu schaffen, die als Einzelschicht, d. h. ohne eine Unterlage- und/oder Deckschicht aus dem System Ni und Cr, einen einstellbaren kleinen TKR ermöglicht. Erfindungsgemäß besteht die Widerstandsschicht aus einer CuNi-Basis-Legierung, die unter Vermeidung einer Unterlage- und/oder Deckschicht auf einem Trägerkörper aufgebracht ist, wobei auf der Widerstandsschicht eine Oxidschicht erzeugt ist. Über die Oxidschichtdicke kann der TKR eingestellt werden. Mit zunehmender Oxidschichtdicke verschiebt sich der TKR von negativen Werten, wie sie zunächst nach der Schichtabscheidung vorhanden sind, zu positiven Werten. Die Schicht ist beispielsweise für Chipwiderstände und Axialwiderstände anwendbar.

DE 197 45 966 C 1

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf das Gebiet der Elektrotechnik/Elektronik und betrifft eine niederohmige Widerstandsschicht mit einstellbarem kleinen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands (TKR). Die Schicht ist beispielsweise für Chipwiderstände und Axialwiderstände anwendbar.

Es sind bereits verschiedene Legierungen und Schichtsysteme für niederohmige Widerstandsschichten bekannt. Die vielfach benutzten NiCr-Schichten eignen sich gut für Flächenwiderstände größer als 5 Ohm/q, nicht aber für Werte darunter. Für diesen Bereich sind auch Niederohmwiderstandsschichten auf CuNi-Basis bekannt (J. Nishino, Y. Ichinose, Y. Sorimachi und I. Tsubata, Int. J. Hybrid Microelectron. 8, 1, 5, 12 (1985)).

Bekannt sind auch Niederohmwiderstandsschichten auf CuNi-Basis mit geringen Anteilen von Übergangsmetallen, beispielsweise mit 1% Mn (DD 292 340). Die Schichten können durch Sputtern auf ein isolierendes Substrat, z. B. auf Aluminiumoxid-Keramik oder oxidierten Si-Scheiben, abgeschieden werden. Die Schichten besitzen eine Unterlage- und/oder Deckschicht aus NiCr.

Für Widerstandsschichten, die Präzisionsanforderungen genügen sollen, ist ein kleiner TKR erforderlich. Dabei sollte der TKR-Wert einstellbar veränderlich sein, um ihn speziellen Anwenderanforderungen anpassen zu können oder um Kontakt- und andere Einflüsse auf den TKR korrigieren zu können.

Die TKR-Einstellung wird meist über eine Wärmebehandlung deutlich oberhalb der maximalen Einsatztemperatur realisiert. Diese Wärmebehandlung erfolgt in inerter oder reduzierender Atmosphäre, z. B. in einem Formergas, das aus einem Stickstoff-Wasserstoff-Gemisch besteht (DD 292 340).

Werkstoffwissenschaftliche Untersuchungen an Cu-NiMn-Einzelschichten der Zusammensetzung Cu₅₇Ni₄₂Mn₁ (W. Brückner, St. Baunack, D. Elefant und G. Reiss, J. Appl. Phys. 79, S. 8516 (1996) haben ergeben, daß bei Wärmebehandlung in Formergas bis 550°C praktisch keine Änderung des TKR auftritt und daß es erst durch die Unterlage- und/oder Deckschicht aus NiCr möglich wird, eine Verschiebung des TKR bei einer Wärmebehandlung zu erreichen. Der TKR der abgeschiedenen Schicht ist negativ, er verschiebt sich durch die Wärmebehandlung zu positiven Werten. Dabei gibt es Reaktionen zwischen den zwei Teilschichten NiCr und CuNi (Mn).

Nachteilig hierbei ist, daß das niederohmige Widerstandsschichtmaterial nur in Verbindung mit NiCr-Unterlage- und/oder Deckschichten die Einstellung eines kleinen TKR-Wertes ermöglicht. Durch die notwendige Abscheidung eines Schichtsystems entsteht ein hoher Aufwand bei der Bebeschichtung.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine niederohmige Widerstandsschicht auf CuNi-Basis zu schaffen, die als Einzelschicht, d. h. ohne eine Unterlage- und/oder Deckschicht aus dem System Ni und Cr, einen einstellbaren kleinen TKR ermöglicht.

Diese Aufgabe ist mit der in den Patentansprüchen beschriebenen Widerstandsschicht gelöst.

Dabei besteht die erfindungsgemäße Widerstandsschicht aus einer CuNi-Basis-Legierung, die unter Vermeidung einer Unterlage- und/oder Deckschicht auf einem Trägerkörper aufgebracht ist, wobei auf der Widerstandsschicht eine Oxidschicht erzeugt ist. Über die Oxidschichtdicke kann der TKR eingestellt werden. Mit zunehmender Oxidschichtdicke verschiebt sich der TKR von negativen Werten, wie sie zunächst nach der Schichtabscheidung vorhanden sind,

zu positiven Werten.

Die CuNi-Basis-Legierung kann zweckmäßigerweise 30 bis 60 Gew.-% Ni, 40 bis 70 Gew.-% Cu und einen möglichen Zusatz von insgesamt bis zu 10 Gew.-% eines oder mehrerer Übergangsmetalle enthalten. Die Schicht kann aus der Legierung mittels Sputtern auf dem Trägerkörper erzeugt worden sein.

Die Oxidschicht kann mittels einer Wärmebehandlung im Temperaturbereich von 300 bis 500°C in sauerstoffhaltiger Atmosphäre gebildet worden sein. Als sauerstoffhaltige Atmosphäre kann Luft, ein Inertgas mit Sauerstoff- oder Luftpzugabe oder auch ein technisches Inertgas mit Restsauerstoff verwendet werden.

Die Dicke der Oxidschicht kann 1% bis 20% der gesamten Schichtdicke betragen.

Der Vorteil der Erfindung gegenüber dem Stand der Technik besteht darin, daß nur eine Einfachschicht aus einem Material auf CuNi-Basis abgeschieden zu werden braucht. Dadurch wird gegenüber der Mehrschichtabscheidung mit zusätzlichem NiCr eine apparative und technologische Vereinfachung erreicht, wenn eine niederohmige Widerstandsschicht mit einem einstellbaren kleinen TKR benötigt wird.

Die Erfindung ist nachfolgend an Hand eines Ausführungsbeispiels näher erläutert.

Eine CuNiMn-Einfachschicht der Zusammensetzung Cu₅₉Ni₄₀Mn₁ wird durch Sputtern auf einem oxidierten Silizium-Substrat hergestellt. Die erzeugte Schicht besitzt eine Dicke von 410 nm, einen Flächenwiderstand von 1,25 Ohm/q und einen TKR-Wert von -54 ppm/K. Nach einer Wärmebehandlung in Argon mit einem Zusatz von 50 vol.-ppm Luft bei 400°C über 0,5 h hat sich auf der Schicht eine Oxidschicht aus dem Schichtmaterial gebildet, die eine Dicke von ≈ 30 nm besitzt. Der Flächenwiderstand hat sich um etwa 5% verringert, der TKR-Wert beträgt +5 ppm/K.

Patentansprüche

1. Niederohmige Widerstandsschicht mit einstellbarem kleinen Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstands TKR, dadurch gekennzeichnet, daß die Widerstandsschicht aus einer CuNi-Basis-Legierung besteht, die unter Vermeidung einer Unterlage- und/oder Deckschicht auf einem Trägerkörper aufgebracht ist, wobei auf der Widerstandsschicht eine Oxidschicht erzeugt ist, deren Dicke den TKR bestimmt.

2. Niederohmige Widerstandsschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die CuNi-Basis-Legierung 30 bis 60 Gew.-% Ni, 40 bis 70 Gew.-% Cu und einen möglichen Zusatz von insgesamt bis zu 10 Gew.-% eines oder mehrerer Übergangsmetalle enthält.

3. Niederohmige Widerstandsschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die CuNi-Schicht mittels Sputtern auf dem Trägerkörper erzeugt ist.

4. Niederohmige Widerstandsschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oxidschicht mittels einer Wärmebehandlung im Temperaturbereich von 300 bis 500°C in sauerstoffhaltiger Atmosphäre gebildet ist.

5. Niederohmige Widerstandsschicht nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Dicke der Oxidschicht 1% bis 20% der gesamten Schichtdicke beträgt.